

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 厚膜绝缘层上硅材料的制备方法

请输入查询关键词

科技频道

搜索

厚膜绝缘层上硅材料的制备方法

关键词: [硅材料](#) [厚膜绝缘层](#) [制备方法](#) [光波导材料](#) [厚膜SOI材料](#)

所属年份: 2003

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所

成果摘要:

该发明专利为制备厚膜SOI(Silicium on insulator)材料的方法,其特征为:以利用SIMOX技术制备的薄SOI材料作为衬底,然后利用气相外延工艺进行外延生长单晶硅层。用该方法制备的SOI材料可以用作光波导材料,外延层厚度可以根据需要控制,外延层表面平整度优于用键合减薄方法制备的SOI材料。外延生长时可选用SiCl₄, SiHCl₃, SiH₂Cl₂或SiH₄作为硅源,外延掺杂类型可以根据需要选择,外延生长前衬底用H₂高温烘烤改善表面状况。外延层硅层厚度为5-10μm,沉积速率为0.3-0.8μm/min。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

- 塔北地区高精度卫星遥感数据处理
- 综合遥感技术在公路深部地质...
- 轻型高稳定度干涉成像光谱仪
- 智能化多用途无人机对地观测技术
- 稳态大视场偏振干涉成像光谱仪
- 2001年土地利用动态遥感监测
- 新疆特克斯河恰甫其海综合利...
- 用气象卫星资料反演蒸散
- 天水陇南滑坡泥石流遥感分析
- 综合机载红外遥感测量系统及...

成果交流

推荐成果

- [容错控制系统综合可信性分析...](#) 04-23
- [基于MEMS的微型高度计和微型...](#) 04-23
- [基于MEMS的载体测控系统及其...](#) 04-23
- [微机械惯性仪表](#) 04-23
- [自适应预估控制在大型分散控...](#) 04-23
- [300MW燃煤机组非线性动态模型...](#) 04-23
- [先进控制策略在大型火电机组...](#) 04-23
- [自动检测系统化技术的研究与应用](#) 04-23
- [机械产品可靠性分析--故障模...](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布